

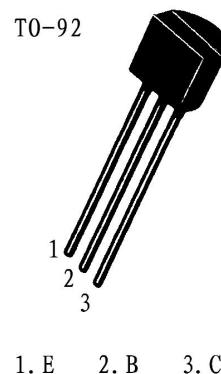
NPN 晶体管

1、封装形式：TO-92

2、互补型号：2N2907

3、极限参数(绝对最大额定值 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数值	单位
集电极-基极电压	BV_{CBO}	50	V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	40	V
集电极最大电流	I_{CM}	0.6	A
耗散功率	P_{CM}	0.625	W
贮存结温	T_j 、 T_{stg}	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$

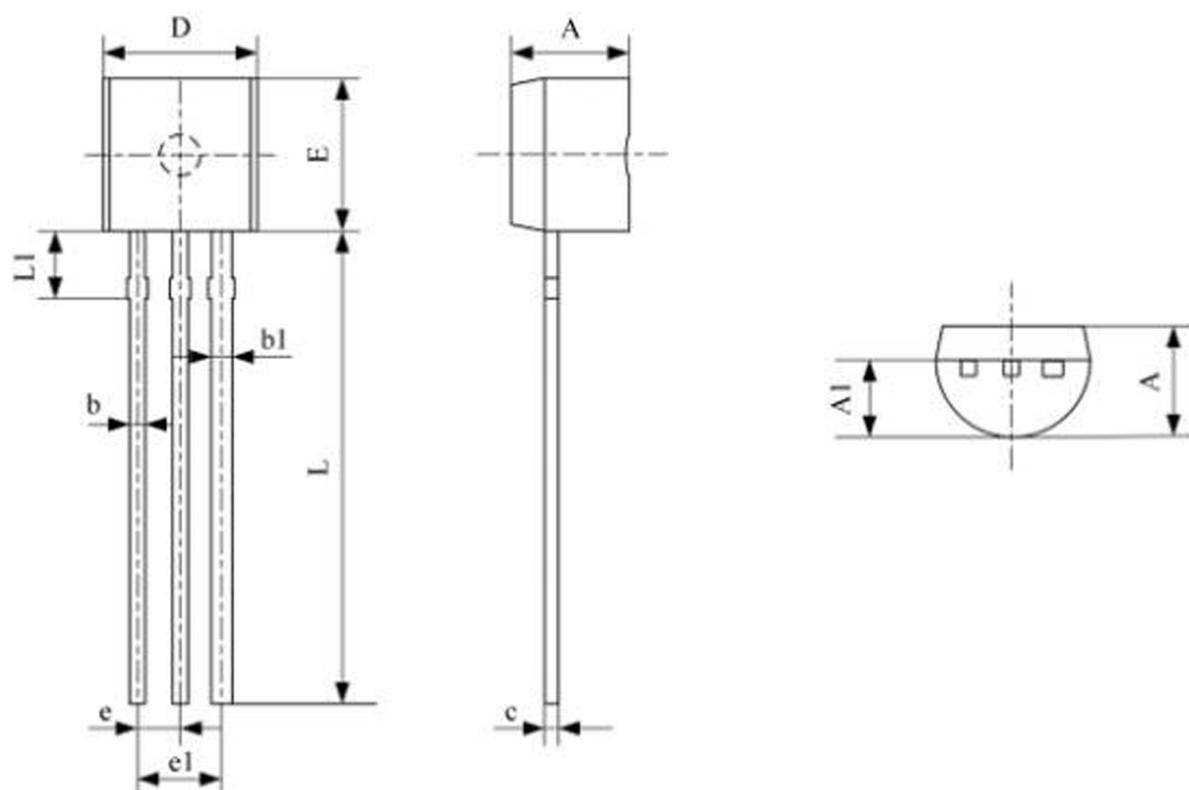


4、电参数特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-基极电压	BV_{CBO}	$I_C = 100\mu\text{A}$, $I_E = 0$	50			V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	$I_C = 100\mu\text{A}$, $I_B = 0$	40			V
发射极-基极电压	BV_{EBO}	$I_E = 100\mu\text{A}$, $I_C = 0$	5			V
集电极-基极漏电流	I_{CBO}	$V_{CB} = 50\text{V}$, $I_E = 0$			0.1	μA
集电极-发射极漏电流	I_{CEO}	$V_{CE} = 40\text{V}$, $I_B = 0$			0.1	μA
发射极-基极漏电流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5\text{V}$, $I_C = 0$			0.1	μA
直流放大倍数	$H_{FE}(1)$	$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_B = 1\text{mA}$	90	250	400	
	$H_{FE}(2)$	$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_B = 5\text{mA}$	90	200	400	
饱和压降	V_{CESAT}	$I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 50\text{mA}$			0.6	V
正向压降	V_{BESAT}	$I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 50\text{mA}$			1.2	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = 10\text{V}$, $I_B = 50\text{mA}$	100			MHz

5、 $H_{FE}(2)$ 分档

分 档			
范 围	150-400		



符号	尺寸 (毫米 mm)		尺寸 (英寸 inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	3.30	3.70	0.130	0.146
A1	2.30	2.70	0.091	0.106
b	0.40	0.50	0.016	0.020
b1	0.50	0.70	0.020	0.028
c	0.35	0.45	0.014	0.018
D	4.45	4.70	0.175	0.185
E	4.40	4.65	0.173	0.183
e	1.17	1.37	0.046	0.054
e1	2.34	2.64	0.092	0.104
L	13.50	14.50	0.531	0.571
L1	1.80	2.20	0.071	0.087